

弊社では、お客様からのご要望に合わせて各種成膜や熱処理を行っております。SiCのアニール前処理として最適なカーボン成膜をPBIIで、アニール処理をRTAでそれぞれ対応可能なため、アニール前後の一連の処理を弊社で行うことができます。それ以外にも、半導体の前工程処理のご要望をお受けしております。

成膜

PBII
カーボン成膜が可能



熱処理

RTA
～1800度までの熱処理が可能



酸化炉
酸化、熱処理

